

Памяти Ж.И. Алферова



Жорес Иванович Алферов – крупнейший советский и российский ученый-физик, политический деятель.

В 1952 г. с отличием окончил ФЭТ ЛЭТИ по специальности «Электроракуумная техника».

В 1970 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Гетеропереходы в полупроводниках». С 1991 до 2017 года - Вице-президент РАН, Председатель Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН.

В 1973 г. Ж.И. Алферов, используя непрекращающуюся тесную связь с ЛЭТИ, создал и возглавил на своем родном факультете электронной техники первую в стране базовую кафедру в ФТИ им. А.Ф. Иоффе, преподавателями которой стали известные ученые.

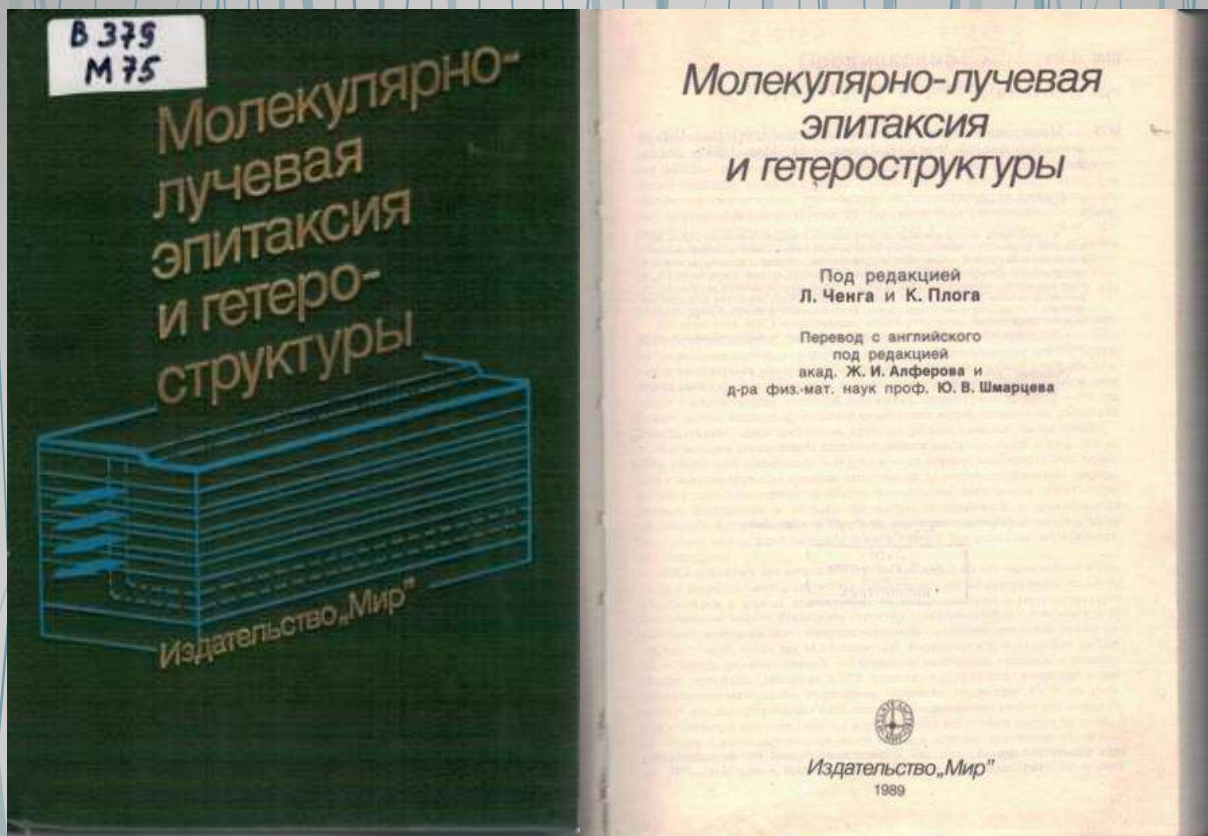
В 2000 г. Ж.И. Алферов получил Нобелевскую премию за открытия в области физики полупроводников. Он создал систему, позволяющую быстро передавать и считывать большой объем информации. На основе его исследований были созданы многие устройства - от сканера товаров в магазине до солнечных батарей и светодиодных ламп.

Параллельно с Ж.И. Алферовым гетеропереход изучали немецкий физик Герберт Кремер и американский исследователь Джек Килби. Нобелевскую премию вручили всем троим, но речь произносил именно Жорес Иванович.

Авторитет Ж.И. Алферова в научной среде чрезвычайно высок - он автор более 500 научных работ, в том числе трех монографий и более 50 изобретений.

2 марта 2019 года Жорес Иванович Алферов ушел из жизни.

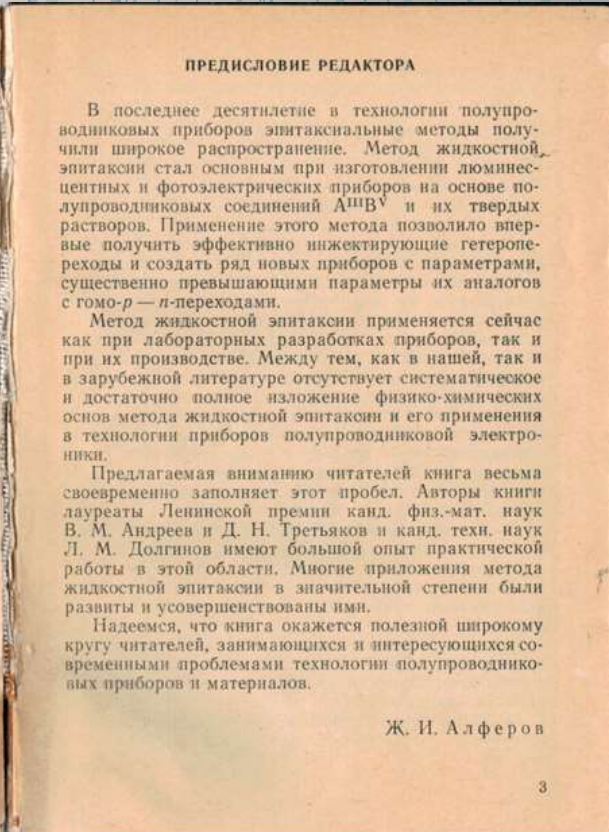
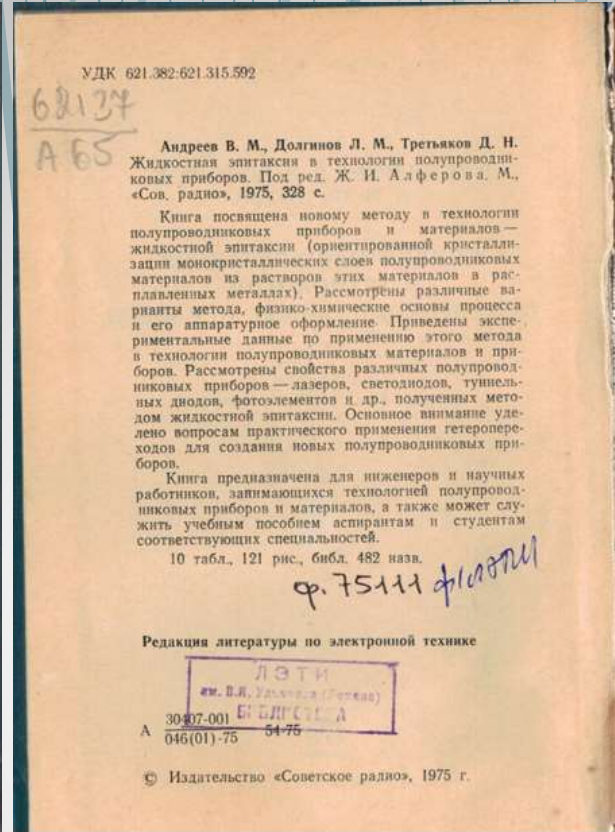
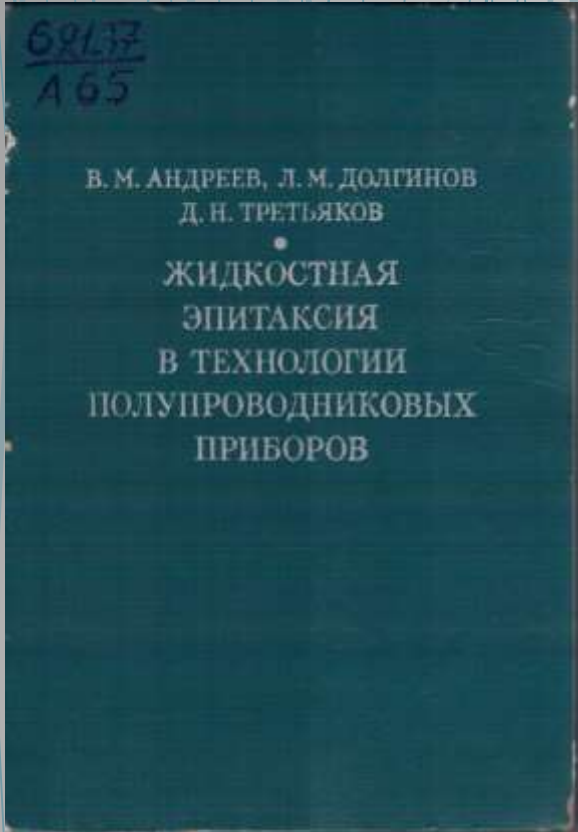
В память о выдающемся ученом сотрудники отдела научной литературы библиотеки подготовили выставку трудов Ж.И. Алферова, а также публикаций о нем. Все издания, представленные на выставке, из фонда истории ЛЭТИ.



В379

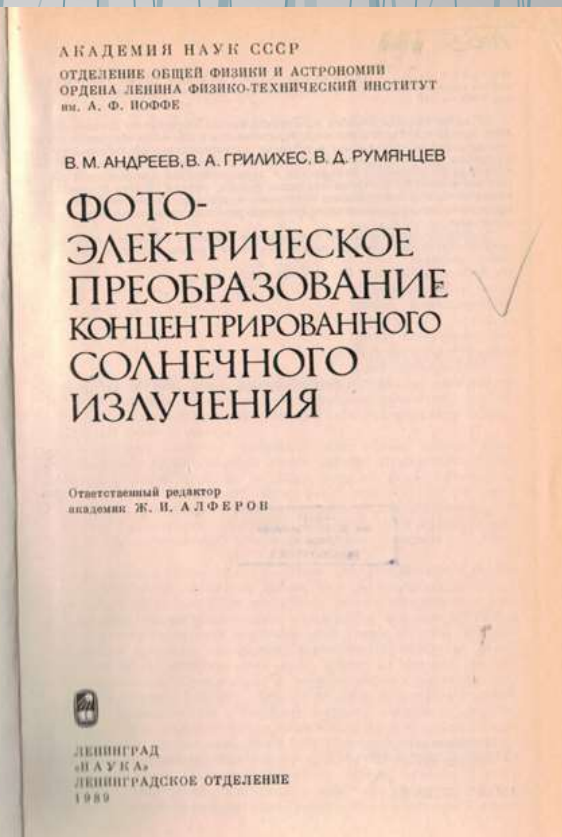
М75

Молекулярно-лучевая эпитаксия и гетероструктуры [Текст] : монография / Под ред. Л.Ченга, К.Плога; Пер. с англ. под ред. Ж.И.Алферова, Ю.В. Шмарцева. – М.: Мир, 1989. - 582 с. : ил.



621.37
A65

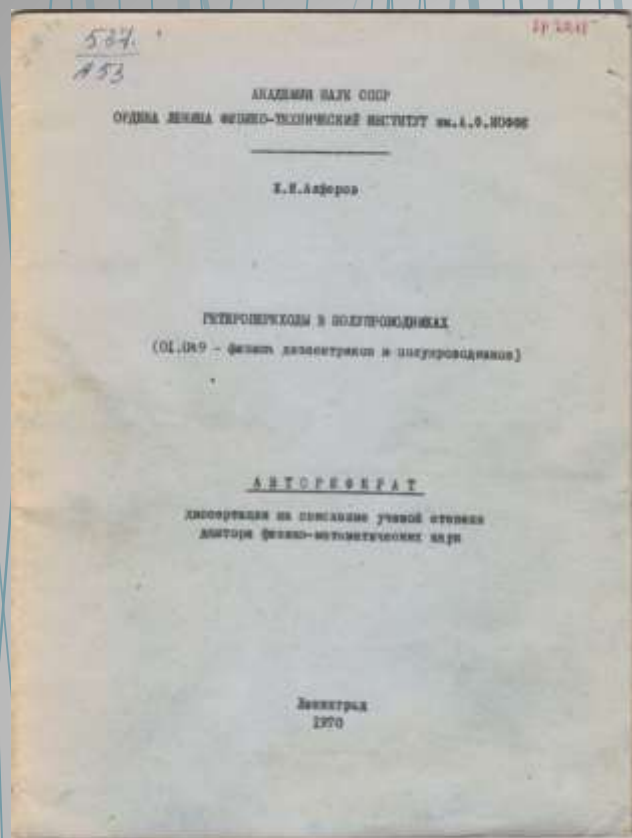
Андреев, Вячеслав Михайлович. Жидкостная эпитаксия в технологии полупроводниковых приборов / В.М. Андреев, Л.М. Долгинов, Д.Н. Третьяков ; ред. Ж.И. Алферов. - М. : Сов. радио, 1975. - 328 с. : ил., табл.



32

A65

Андреев, Вячеслав Михайлович. Фотоэлектрическое преобразование концентрированного солнечного излучения: монография / В.М.Андреев, В.А.Гриликес, В.Д.Румянцев; Отв. ред., авт. предисл. Ж.И. Алферов; АН СССР, Отд. общей физики и астрономии, Физ.-тех. ин-т им. А.Ф. Иоффе. - Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1989. - 309 с.



537

A53

Алферов, Жорес Иванович. Гетеропереходы в полупроводниках (01.049 – Физика диэлектриков и полупроводников): автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук. – Л., 1970. – 26 с.



B3

A53

Алферов, Жорес Иванович. Физика XXI века: выступление Почетного доктора Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов Жореса Ивановича Алферова 9 апреля 1998 года / Ж.И. Алферов ; Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. - СПб. : ГУП, 1999. - 30 с. : фото.цв. - (Golden Pages).



385
Ф18

Алферов, Жорес Иванович. Базовая кафедра оптоэлектроники при физико-технологическом институте им. А.Ф. Иоффе / Ж. И. Алферов, В. М. Андреев, В. И. Кучинский // Факультету электронной техники - 50 лет: монография / СПбГЭТУ. - СПб. : Изд-во ГЭТУ, 1996. - С. 69-78.

С
Ф
А
385
П29

ПЕТЕРБУРГСКАЯ-ЛЕНИНГРАДСКАЯ ШКОЛА ЭЛЕКТРОНИКИ



ДВОЙНЫЕ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ: КОНЦЕПЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ В ФИЗИКЕ, ЭЛЕКТРОНИКЕ И ТЕХНОЛОГИИ¹

Сегодня невозможно представить себе современную физику твердого тела без полупроводниковых гетероструктур. Полупроводниковые гетероструктуры, и в особенности двойные гетероструктуры, включая квантовые ямы, арсениды и фосфиды, являются в наше время предметом исследования 2/3 академических групп, работающих в области физики полупроводников.

Если возможность управления типом проводимости полупроводника с помощью легирования различными примесями и идеи инжекции неравновесных носителей заряда были теми семенами, из которых выросла полупроводниковая электроника, то гетероструктуры позволили решить значительно более общую проблему управления фундаментальными параметрами и полупроводниковых кристаллах и приборах, таких как ширина запрещенной зоны, эффективные массы носителей заряда и их подвижность, показатель преломления, электронный инерционный спектр и т. д.

Различные физики и технологи полупроводниковых гетероструктур привнес в цивилизованную цивилизацию в нашей повседневной жизни. Электроника на гетероструктурах широко используется во многих областях человеческой деятельности. Едва ли можно представить нашу жизнь без телекоммуникационных систем, основанных на лазерах с двойной гетероструктурой (ДГС), без гетероструктурных светодиодов и биполярных транзисторов, без маломощных транзисторов с высокой подвижностью электронов (ВМПЭТ) для высокочастотных применений, включая, например, системы спутниковой телевидения. ДГС-лазеры присутствуют сейчас практически в каждом доме в проигрывателях для лазерных дисков. Сложные элементы на гетероструктурах широко используются как в космосе, так и на земле.

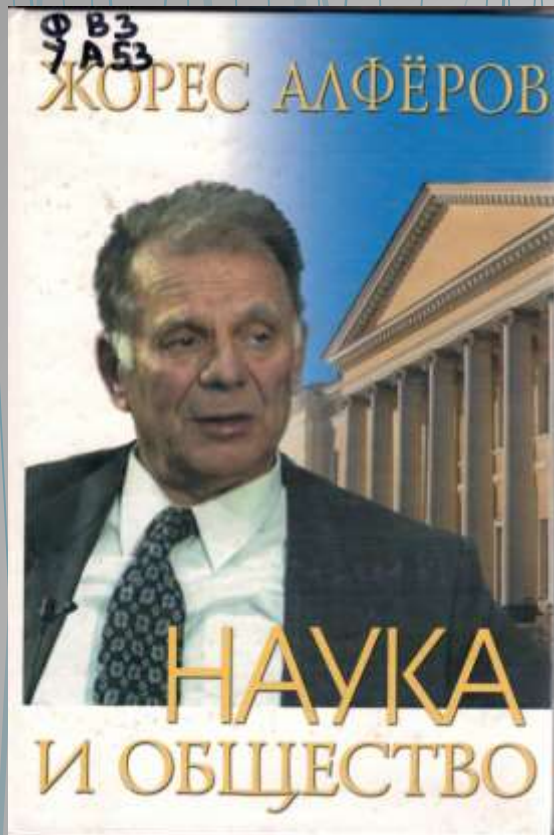
Наш интерес к полупроводниковым гетероструктурам не был случайным. Систематические исследования полупроводников были начаты еще в 30-е годы в Физико-техническом институте под прямым руководством его основателя — Михаила Федоровича Иоффе. В 1932 году В. П. Жузе и Б. В. Курятов исследовали собственную и примесную проводимость полупроводников, и в том же году А. Ф. Иоффе и И. И. Френкель создали теорию выпрямления тока на контакте металл-полупроводник, основанную на явлении туннелирования [1]. В 1933 и 1936 годах И. И. Френкель опубликовал свои знаменитые работы, в которых он предсказал экситоны в полупроводниках, выявил сам это явление и разработал теорию экситоника, а Е. Ф. Пресс экспериментально открыл экситоны в 1951 году [2]. Первая диффузионная теория выпрямленного $p-n$ -перехода, которая стала основой теории $n-p$ -перехода У. Шокли, была опубликована Б. И. Давыдовым в 1939 году [3]. По инициативе А. Ф. Иоффе с конца 40-х годов в Физико-техническом институте были начаты ис-

¹ Нобелевская лекция прочитана 9 декабря 2001 г. в Стокгольме и опубликована на английском языке в официальной публикации Нобелевского комитета. Запись презентации англоязычной версии, которая опубликована в 2002 году (УФФ, 2002, Т. 472, № 9, С. 1073-1084), опубликована по инициативе Алферов Ж. И. Эпоса и обобщена / Ж. И. Алферов. Физико-технологический институт А. Ф. Иоффе. СПб.: Наука, 2005.

385

П29

Алферов, Жорес Иванович. Двойные гетероструктуры: концепция и применение в физике, электронике и технологии // Петербургская-Ленинградская школа электроники / [редкол.: Ж. И. Алферов гл. ред. [и др.]. - СПб. : Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2013. - С. 89-115 : ил. - Библиогр.: 89 назв.



Академик Жорес Алферов:
ФАНТАСТИКА В ЗЕРКАЛЕ НАУКИ

“Честь и слава тому, кто употребляет избыток своего достояния на оказание полезных трудов, на усовершенствование отечественной словесности, на доставление пособий тем, которые посвящают себя постоянным усилиям и скромной славе учености” – академик Г.А. Мещеряков эти слова, сказанные в начале XIX века графом С.С. Уваровым, который как президент Российской академии наук вручал впервые Демидовские премии. Геннадий Андреевич не случайно напомнил о данных событиях: тем самым он подчеркивал преемственность науки, ее традиции отмечать высшими премиями своих верных служителей.

В последний год уходящего тысячелетия среди лауреатов оказался и академик Жорес Иванович Алферов. И произошло это закономерно, так как он принадлежит к той плеяде ученых, которые добились высочайших успехов в своей отрасли науки. Впрочем, в дипломе лауреата так и сказано: “За выдающийся вклад в развитие физики полупроводников и квантовой полупроводниковой электроники”.

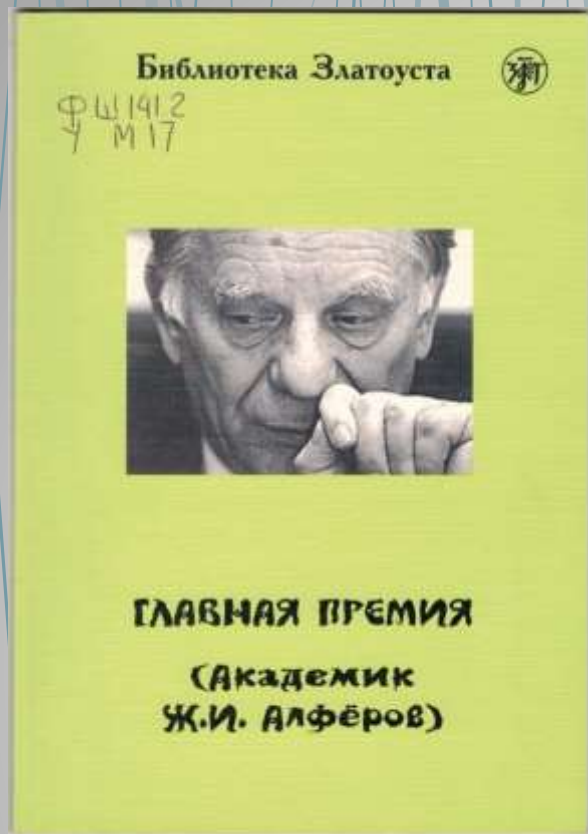
Бесмысленно расширять академика о его конкретных работах – для непосвященного они сразу же превращаются в широмождение расчетов, построение сложных кривых и массу абстрактных понятий, понятных только специалисту высокой квалификации. Тут не только добротного среднего образования не хватает, но подчас даже и высшего. А потому я поначалу задавал вопрос ученому довольно общий, мол, не мог бы он представить, какие наиболее интересные достижения науки нас ждут в XXI веке?

Жорес Иванович ответил:
 — Фантастика лучше удается писателям. Как только мы об этом говорим, то первое имя, которое приходит в голову, Жюль Верн. И подобие вполне объяснимо, так как специалисты связали неким грузом знаний, и очень трудно свободно фантазировать. Есть такая шутка. Однажды Эйнштейна спро-

**В3
 А53**
Алферов, Жорес Иванович. Наука и общество / Ж.И. Алферов ; Российская академия наук. Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе. - СПб. : Наука, 2005. - 383 с. : ил.

**Ч213
 Г93**
Алферов, Жорес Иванович. Фантастика в зеркале науки / Ж.И. Алферов // Губарев, В. С. XX век. Исповеди: судьба науки и ученых в России: речи и другие риторические формы / В.С. Губарев. - М. : Наука/Интерпериодика, 2000. - С. 583-590.

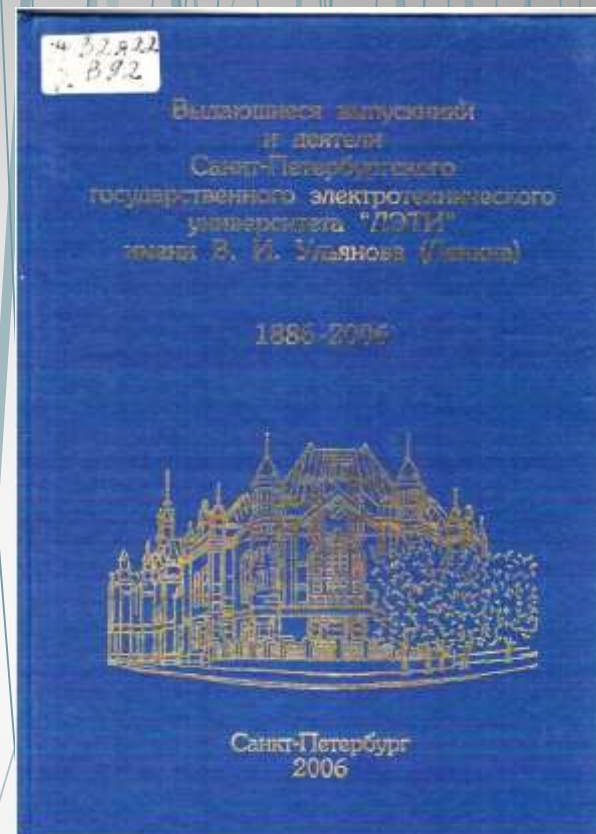
Издания о Ж.И. Алферове



Ш141.2

М74

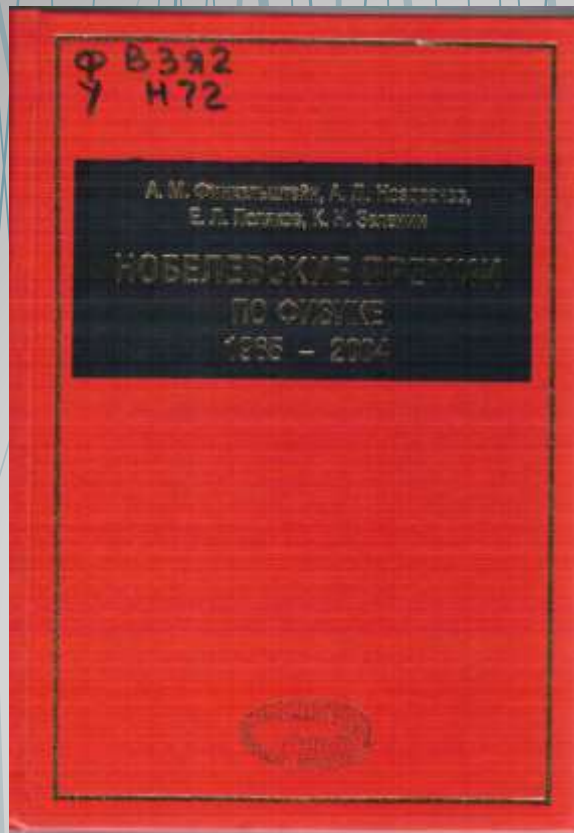
Максимова, А. Л. Главная премия (Академик Ж.И. Алферов) / А.Л. Максимова, А.В. Голубева. - СПб. : Златоуст, 2002. - 39 с. : фото.



32я22

В92

Выдающиеся выпускники и деятели Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова (Ленина). 1886 - 2006 : биограф. справ. / под общ. ред. Д.В. Пузанкова. - СПб. : Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2006. - С. 20 - 21. : фото.



В3я2

Н72

Нобелевские премии по физике: 1901 - 2004 : в 2 т. / А.М. Финкельштейн, А.Д. Ноздрачев, Е.Л. Поляков, К.Н. Зеленин. - СПб. : Гуманистика, 2005. - Т. 2. - С. 961 – 979. : ил.

385
Ф 695

Ю. А. БЫСТРОВ

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ГОДЫ



крыт для обывака. Если даже это удастся, то факультет, возглавляемый им, останется, а университет останется признанным лидером в стране по направлению, в котором работает кафедра факультета.

В.З. Выдающийся выпускник университета – Ж. Н. Алферов

В 2006 г. произошло знаменитое событие в истории нашего вуза – выпускнику факультета электротехнической техники Жоресу Ивановичу Алферову была присуждена самая престижная в мире Нобелевская премия по физике. В краткой биографической справке, распространенной жюри информативные сведения о нем, указывается название того высшего учебного заведения, которое окончил лауреат. Так вот, весь мир узнал, что Ж. И. Алферов окончил Ленинградский электротехнический институт им. В. И. Ульянова (Ленина).

За всю историю Советского Союза и Российской Федерации Нобелевской премией были удостоены десять наших физиков и ученые они в следующем ряду: Московский государственный университет – Алексей Абрикосов, Николай Гинзбург, Игорь Тамм и Лева Франк; Ленинградский государственный университет – Лев Ландау и Александр Прохоров; Ленинградский электротехнический институт – Жорес Алферов; Ленинградский инженерно-физический институт – Петр Капица; Московский инженерно-физический институт – Николай Босов; Воронежский государственный университет – Петр Черенков.



Принимая Нобелевскую премию Ж. И. Алферов

Таим образом, из нескольких сотен вузов, существовавших в стране, всего шесть вузов могут гордиться тем, что они подготовили своих выдающихся физиков мира. Это свидетельствует о том, что в вузе был, и в смысле подготовки, будет сохраняться высокий уровень подготовки специалистов, это свидетельствует о той атмосфере творчества, научного поиска, которыми всегда отличался наш ЭЭТИ.

Жорес Иванович родился 13 января 1926 г. в Витебске. Родители его, Анна Владимировна и Иван Карлович, как большинство людей их поколения, верили в революционное идею. Именно это

идея привлекла революционно настроенные родители двинуть своего ребенка учиться в Ленинград. Так, старший сын, родившийся 1 января 1926 г. был младшим Андреем, а младший – Жоресом и мать Жана Жирети, основательница французской совхозостроительской службы.

385

695

Быстров, Юрий Александрович. Взгляд сквозь годы: история каф. в событиях, лицах, фактах / Ю. А. Быстров. - СПб. : Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2008. - 314, [3] с. : фот.



"История науки,
образования и техники"

СЕРИЯ

ВЫПУСК 1

**ПОЧЕТНЫЕ ДОКТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА "ЛЭТИ"**

УДК 621(091)

Об официальном вручении

**ВРУЧЕНИЕ АКАДЕМИКУ Ж. И. АЛФЕРОВУ ДИПЛОМА ПОЧЕТНОГО
ДОКТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА "ЛЭТИ"**

Крупнейший центр научной и образовательной деятельности в области радиотехники, электротехники, физики и химии в Санкт-Петербурге - государственный университет имени В. И. Ленина - вручил академику Ж. И. Алферову почетный диплом.

Ж. И. Алферов, генеральный директор ЛЭТИ, Физик, Нобелевский лауреат



23 февраля 2003 г. в здании в центре Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета, что уже в тридцать девятый раз вручили почетный диплом почетному доктору Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета академику Жюри Ивановичу Алферову. В этот раз университетская комиссия вручила почетный диплом почетному доктору ЛЭТИ вице-президенту Академии наук России, директору Физико-математического института, члену Высшего совета Российской академии наук, члену Президиума Российской академии наук академику Ж. И. Алферову.

Торжественно вручил Ж. И. Алферову почетный диплом почетному доктору ЛЭТИ вице-президенту Академии наук России, директору Физико-математического института, члену Высшего совета Российской академии наук, члену Президиума Российской академии наук академику Жюри Ивановичу Алферову. Вручение диплома состоялось в торжественной обстановке в здании ЛЭТИ.

Торжественно вручил Ж. И. Алферову почетный диплом почетному доктору ЛЭТИ вице-президенту Академии наук России, директору Физико-математического института, члену Высшего совета Российской академии наук, члену Президиума Российской академии наук академику Жюри Ивановичу Алферову.

Нобелевский лауреат по физике за 2000 г., лауреат в области физики Ленинской премии за 1971 г., лауреат премии Ленинского комсомола за 1972 г. за фундаментальные исследования в области физики полупроводников и лазерной физики академик Ж. И. Алферов имеет с университетом тесные связи. Он является членом совета ЛЭТИ, членом комиссии по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, членом комиссии по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, членом комиссии по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, членом комиссии по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, членом комиссии по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, членом комиссии по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.

УДК 621(091)

Ж. И. Алферов

Ж. И. АЛФЕРОВ: СТУДЕНТ-ПРОФЕССОР-НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ

Рассказывая о жизни и деятельности выдающегося ученого, лауреата Нобелевской премии академика Жюри Ивановича Алферова, в это время в образовательной деятельности.

Ж. И. Алферов, СПбГЭТУ "ЛЭТИ", ФТИ им. А. Ф. Иоффе, кафедра интегральной физики

Первый наш доклад закончился тем, что Жюри Иванович Алферов - выдающийся физик-полупроводник, в котором наш современник работает последние 27 лет. Целый ряд работ в области физики полупроводников, в том числе работы по созданию полупроводниковых лазеров, выполненных в ФТИ им. А. Ф. Иоффе, являются основой для создания современных полупроводниковых лазеров. Жюри Иванович Алферов - выдающийся физик-полупроводник, в котором наш современник работает последние 27 лет. Целый ряд работ в области физики полупроводников, в том числе работы по созданию полупроводниковых лазеров, выполненных в ФТИ им. А. Ф. Иоффе, являются основой для создания современных полупроводниковых лазеров.

Перед Великой Отечественной войной совместно с академиком А. М. Прохоровым впервые разработана конструкция полупроводникового лазера с инжекцией носителей заряда (на основе при исследовании полупроводниковых диодов) и в кратчайшие сроки были построены первые полупроводниковые лазеры. Преподобный профессор полупроводниковых приборов страны в то время. Если бы это не было связано, то страны не было бы известно, что такое лазер. Это было бы только в будущем (тогда, если бы не было бы известно, что такое лазер).

Однако не только по своим научным заслугам Жюри Иванович Алферов является выдающимся ученым. Он также является выдающимся педагогом. Он воспитал много талантливых ученых, которые внесли вклад в развитие науки и техники. Он также является выдающимся педагогом. Он воспитал много талантливых ученых, которые внесли вклад в развитие науки и техники.

Жюри Иванович Алферов - выдающийся физик-полупроводник, в котором наш современник работает последние 27 лет. Целый ряд работ в области физики полупроводников, в том числе работы по созданию полупроводниковых лазеров, выполненных в ФТИ им. А. Ф. Иоффе, являются основой для создания современных полупроводниковых лазеров.

Жюри Иванович Алферов - выдающийся физик-полупроводник, в котором наш современник работает последние 27 лет. Целый ряд работ в области физики полупроводников, в том числе работы по созданию полупроводниковых лазеров, выполненных в ФТИ им. А. Ф. Иоффе, являются основой для создания современных полупроводниковых лазеров.

Жюри Иванович Алферов - выдающийся физик-полупроводник, в котором наш современник работает последние 27 лет. Целый ряд работ в области физики полупроводников, в том числе работы по созданию полупроводниковых лазеров, выполненных в ФТИ им. А. Ф. Иоффе, являются основой для создания современных полупроводниковых лазеров.

Жюри Иванович Алферов - выдающийся физик-полупроводник, в котором наш современник работает последние 27 лет. Целый ряд работ в области физики полупроводников, в том числе работы по созданию полупроводниковых лазеров, выполненных в ФТИ им. А. Ф. Иоффе, являются основой для создания современных полупроводниковых лазеров.

Жюри Иванович Алферов - выдающийся физик-полупроводник, в котором наш современник работает последние 27 лет. Целый ряд работ в области физики полупроводников, в том числе работы по созданию полупроводниковых лазеров, выполненных в ФТИ им. А. Ф. Иоффе, являются основой для создания современных полупроводниковых лазеров.

Жюри Иванович Алферов - выдающийся физик-полупроводник, в котором наш современник работает последние 27 лет. Целый ряд работ в области физики полупроводников, в том числе работы по созданию полупроводниковых лазеров, выполненных в ФТИ им. А. Ф. Иоффе, являются основой для создания современных полупроводниковых лазеров.

*Алферов Ж. И. Физик и инженер. СПб. Наука, 2000.

Быстров, Юрий Александрович. Ж.И. Алферов: студент – профессор - Нобелевский лауреат / Ю.А. Быстров // Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ". Сер. "История науки, образования и техники". - 2003. - Вып. 1. - С. 12-18.

Вручение академику Ж.И. Алферову диплома почетного доктора Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" // Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ". Сер. "История науки, образования и техники". - 2003. - Вып. 1. - С. 10-11.



К 70-летию академика Ж.И. Алферова // Известия СПбГЭТУ. Сер. "История науки, образования и техники". - СПб. : Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2000. - Вып. 2. - С. 3.

Андреев, Вячеслав Михайлович. Жорес Иванович Алферов / В.М. Андреев // Известия СПбГЭТУ. Сер. "История науки, образования и техники". - СПб. : Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2000. - Вып. 2.

ЭЛЕКТРИК

Государственный
электротехнический
университет
Санкт-Петербург



Око Вселенной или Слава Жоресу!

Этот номер посвящен лауреату Нобелевской премии в области физики Игорю Ивановичу Алферову.

Очень хочется сказать еще раз, что Игорь Иванович — наш! Выпущенный в 1928, он в последующие годы с пользой и трудом 27 лет заведует кафедрой радиоэлектроники.

Сколько удивительно, что 23 февраля 2001 года в нашем университете состоится вручение диплома и премии Почетного доктора ГИЭУ (ЭТН) академику, лауреату Нобелевской премии Игорю Ивановичу Алферову.

С женой, работая, увлеченно Игорь Иванович рассказывает сегодня его коллегам, коллегам-молодым, друзьям.

Игорю Ивановичу Алферову посвящается

Иван Иванович Алферов (1928-2000) — выдающийся физик, лауреат Нобелевской премии (1992), Почетный доктор ГИЭУ (1998). Он был одним из основоположников современной теории полупроводниковых лазеров. Его работы в области физики полупроводников и лазерной техники имеют огромное значение для развития науки и техники в нашей стране. Он был членом Академии наук СССР и Академии наук Украины. Его именем названы кафедра радиоэлектроники и институт физики полупроводников в ГИЭУ.

Игорь Иванович Алферов, академик РАН, Почетный доктор ГИЭУ, лауреат Нобелевской премии, профессор ГИЭУ, профессор ИФП РАН, профессор ИФП НАН Украины, профессор ИФП НАН Беларуси, профессор ИФП НАН Казахстана, профессор ИФП НАН Узбекистана, профессор ИФП НАН Таджикистана, профессор ИФП НАН Кыргызстана, профессор ИФП НАН Молдовы, профессор ИФП НАН Грузии, профессор ИФП НАН Армении, профессор ИФП НАН Азербайджана, профессор ИФП НАН Казахстана, профессор ИФП НАН Узбекистана, профессор ИФП НАН Таджикистана, профессор ИФП НАН Кыргызстана, профессор ИФП НАН Молдовы, профессор ИФП НАН Грузии, профессор ИФП НАН Армении, профессор ИФП НАН Азербайджана.

Игорь Иванович Алферов, академик РАН, Почетный доктор ГИЭУ, лауреат Нобелевской премии, профессор ГИЭУ, профессор ИФП РАН, профессор ИФП НАН Украины, профессор ИФП НАН Беларуси, профессор ИФП НАН Казахстана, профессор ИФП НАН Узбекистана, профессор ИФП НАН Таджикистана, профессор ИФП НАН Кыргызстана, профессор ИФП НАН Молдовы, профессор ИФП НАН Грузии, профессор ИФП НАН Армении, профессор ИФП НАН Азербайджана.

Игорь Иванович Алферов, академик РАН, Почетный доктор ГИЭУ, лауреат Нобелевской премии, профессор ГИЭУ, профессор ИФП РАН, профессор ИФП НАН Украины, профессор ИФП НАН Беларуси, профессор ИФП НАН Казахстана, профессор ИФП НАН Узбекистана, профессор ИФП НАН Таджикистана, профессор ИФП НАН Кыргызстана, профессор ИФП НАН Молдовы, профессор ИФП НАН Грузии, профессор ИФП НАН Армении, профессор ИФП НАН Азербайджана.



Вручение Нобелевской премии академику Игорю Ивановичу Алферову в Стокгольме, Швеция, 1992 год.

Борис Захарович

по поводу присуждения Ж. И. Алферову Нобелевской премии по физике

Игорю Ивановичу Алферову присуждена Нобелевская премия по физике за открытие и разработку полупроводниковых лазеров. Это открытие имеет огромное значение для науки и техники. Алферов — выдающийся физик, который внес огромный вклад в развитие физики полупроводников. Его работы в области физики полупроводников и лазерной техники имеют огромное значение для развития науки и техники в нашей стране.

Алферов — один из основоположников современной теории полупроводниковых лазеров. Его работы в области физики полупроводников и лазерной техники имеют огромное значение для развития науки и техники в нашей стране. Он был членом Академии наук СССР и Академии наук Украины. Его именем названы кафедра радиоэлектроники и институт физики полупроводников в ГИЭУ.

Алферов — выдающийся физик, который внес огромный вклад в развитие физики полупроводников. Его работы в области физики полупроводников и лазерной техники имеют огромное значение для развития науки и техники в нашей стране. Он был членом Академии наук СССР и Академии наук Украины. Его именем названы кафедра радиоэлектроники и институт физики полупроводников в ГИЭУ.



Игорю Ивановичу Алферову присуждена Нобелевская премия по физике за открытие и разработку полупроводниковых лазеров. Это открытие имеет огромное значение для науки и техники. Алферов — выдающийся физик, который внес огромный вклад в развитие физики полупроводников. Его работы в области физики полупроводников и лазерной техники имеют огромное значение для развития науки и техники в нашей стране.

Алферов — один из основоположников современной теории полупроводниковых лазеров. Его работы в области физики полупроводников и лазерной техники имеют огромное значение для развития науки и техники в нашей стране. Он был членом Академии наук СССР и Академии наук Украины. Его именем названы кафедра радиоэлектроники и институт физики полупроводников в ГИЭУ.

Алферов — выдающийся физик, который внес огромный вклад в развитие физики полупроводников. Его работы в области физики полупроводников и лазерной техники имеют огромное значение для развития науки и техники в нашей стране. Он был членом Академии наук СССР и Академии наук Украины. Его именем названы кафедра радиоэлектроники и институт физики полупроводников в ГИЭУ.

Око Вселенной или Слава Жоресу! // Электрик. - 2001. - Ст. № 3 (2911) : фото.

ЭЛЕКТРИК

Январь 2016 Санкт-Петербург


ЛЭТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ


Издаётся с 1928 года

№1 (3172)

Адрес редакции:
197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 5,
3-й корпус, 1-й этаж, комната 3175

Свидетельство о регистрации СМИ № ПС77-013/2014 от 19.05.2014 г.

 www.eltech.ru

 elektrik@eltech.ru

 346-08-71



Жорес Иванович АЛФЕРОВ, лауреат Нобелевской премии по физике, вице-президент РАН, предсе-

**ЖОРЕС АЛФЕРОВ,
ВЫПУСКНИК ЛЭТИ
1952 ГОДА:
«ТО, ЧТО УЗНАЁШЬ
В МОЛОДОСТИ,
ОСТАЁТСЯ
С ТОБОЙ
НА ВСЮ ЖИЗНЬ...»**

Во времена моей студенческой юности Электротехнический институт имени В.И. Ульянова (Ленина) являлся лучшим вузом страны в том, что мы называли слаботочной электротехникой. Это был лучший вуз в области радиотехники и вакуумной электроники. И, безусловно, в этой области были заложены очень мощные традиции.

Когда я поступал в институт, полупроводниковая электроника еще только рождалась. Этим направлением я стал заниматься на третьем курсе. Очень мощным в образовательном плане оно тогда еще не было. Но это был популярный в городе институт с очень хорошим образованием в области классической электроники и радиотехники.

Добавлю к этому, что мы славимся еще и своими спортивными и музыкальными традициями. Иногда мы шутили, что назв ЛЭТИ – это спортив-